This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



End of Result Set

Generate Collection Print

L10: Entry 1 of 1

File: DWPI

.Oct 23, 1995

DERWENT-ACC-NO: 1992-317485

DERWENT-WEEK: 199851

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Material for passive electronic components - comprises aluminium@ and/or magnesium@ and ceramic of green silicon carbide particles or poly-granular graphite

INVENTOR: DERMARKAR, S; DUMANT, X; LEBAILLY, M

PATENT-ASSIGNEE: PECHINEY RECH (PECH)

PRIORITY-DATA: 1991EP-0420097 (March 22, 1991), 1991NO-0001253 (March 27, 1991), 1991CA-2038832 (March 22, 1991), 1991JP-0104862 (April 10, 1991), 1991KR-0005549 (April 8, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
KR 9512940 B1	October 23, 1995		000	H01B001/22
EP 504532 A1	September 23, 1992	F	010	H01L023/373
NO 9101253 A	September 28, 1992		000	H01L023/00
CA 2038832 A	September 23, 1992	F	000	H01B001/24
JP <u>04329845</u> A	November 18, 1992		007	C22C029/06
JP 95026174 B2	March 22, 1995		007	C22C029/06
CA 2038832 C	September 12, 1995	F	000	H01B001/24

DESIGNATED-STATES: AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

CITED-DOCUMENTS:1.Jnl.Ref; CH 656022 ; EP 64264 ; GB 2206451 ; US 4352120 ; US 4569692 ; US 4649990

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
KR 9512940B1	April 8, 1991	1991KR-0005549	
EP 504532A1	March 22, 1991	1991EP-0420097	
NO 9101253A	March 27, 1991	1991NO-0001253	
CA 2038832A	March 22, 1991	1991CA-2038832	
JP04329845A	April 10, 1991	1991JP-0104862	
JP95026174B2	April 10, 1991	1991JP-0104862	
JP95026174B2		JP 4329845	Based on
CA 2038832C	March 22, 1991	1991CA-2038832	

INT-CL (IPC): C04B 35/52; C04B 35/54; C04B 35/56; C04B 35/565; C22C 29/06; H01B 1/22; H01B 1/24; H01L 23/00; H01L 23/14; H01L 23/15; H01L 23/373

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 504532A BASIC-ABSTRACT:

Material has a thermal expansion coefficient of less than 13 ppm/K, a density of less than 3100 kg/cu.m. and an isotropic structure and consists of (i) a metal selected from Al, Mg and their alloys, and (ii) 50-90 vol.% ceramic selected from green silicon carbide particles and polygranular graphite.

Pref. the metal is Al alloy A356 or A357. When component (ii) comprises 50-75 vol.% green silicon carbide particles, the material has a thermal expansion coefficient of 7-13 ppm/K, a thermal conductivity of more than 150 W/m.K and a Young's modulus of more than 120 GPa. When component (ii) comprises 65-85 vol.% polygranular graphite, the material has a thermal expansion coefficient of 4-10 ppm/K, a density of less than 2300 kg/cu.m., a thermal conductivity of more than 100 W/m.K and a Young's modulus of less than 50 GPa.

USE/ADVANTAGE - The material is useful for heat sinks, supports and pole pieces of power circuits, laser diode supports or encapsulation housings for hybrid power circuits or microwave circuits. It has isotropic properties of low thermal expansion coefficient (2-13 ppm/K at 30-250 deg.C), low density and high thermal conductivity (more than 100 W/m.K).

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 504532A EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

DERWENT-CLASS: LO3 U11 U14 V04

CPI-CODES: L02-H02A; L02-H04; L02-J01; L04-C25;

EPI-CODES: U11-D01A; U11-D01A4; U11-D02B; U14-H04B1; V04-S01A; V04-T03A;

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-329845

(43) Date of publication of application: 18.11.1992

(51)Int.CI.

C22C 29/06 H01L 23/15

(21)Application number: 03-104862

(71)Applicant : PECHINEY RECH GROUP

INTERET ECONOMIQUE REGIE

PAR ORDONNANCE DU 23

SEPTEMBRE 1967

(22)Date of filing:

10.04.1991

(72)Inventor: SARAM DELMALCARL

XAVIER DUMAN MICHEL LEVY

(54) MATERIAL FOR AUXILIARY ELECTRONIC PARTS

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a passive electronic part material having isotropy, high heat conductivity, low density and low coefficient of thermal expansion, by constituting a material of specific ratios of Al, Mg or their alloy and ceramics of green SiC or many grain state graphite. CONSTITUTION: This material is constituted of the metal selected from AI, AI alloy, Mg and Mg alloy, and the ceramics of the green SiC grain or many grain state graphite to obtain a producing material for passive electronic parts. At this time, the ceramic at 50-90 vol.% and Al alloy 356 or 357 as the metal are used to obtain an isotropic physical characteristics structure having ≤13×10-6/K coefficient of thermal expansion and ≤3100 kg/m3 density. Further, the material containing 50-75% green SiC grains causes 7-13×10-6/K coefficient of thermal expansion, ≥150 W/m/K heat conductivity and ≥120 GPa Young's modulus, and the material containing 65-85% multi-granular graphite causes 4-10×10-6/K coefficient of thermal expansion, ≤2300 kg/m3 density, ≥100W/m/K heat conductivity and ≤50 GPa Young's modulus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

Material for passive electronic components.

Patent Number:

F EP0504532

Publication date:

1992-09-23

Inventor(s):

DERMARKAR SALIM (FR); DUMANT XAVIER (CA); LEBAILLY MICHEL (FR)

Applicant(s)::

PECHINEY RECHERCHE (FR)

Requested Patent: CA2038832

Application

Number:

EP19910420097 19910322

Priority Number(s): EP19910420097 19910322; CA19912038832 19910322; JP19910104862

19910410

IPC Classification:

H01L23/373

EC Classification: Equivalents:

H01L23/373C, H01L23/373M ☐ JP4329845, JP7026174B

Abstract

The invention relates to a material for passive electronic components having a high thermal conductivity, a low density and a low dilatation coefficient. It is characterised in that it consists of an isotropic composite material formed from a metal belonging to the group composed of pure aluminium, pure magnesium and their alloys and of a ceramic belonging to the group composed of silicon carbide, graphite and their variants, these elements being chosen precisely in terms of their structure and their relative proportions. This material is used in particular in electronics for making heat dissipation devices, supports, thermal sinks and encapsulation casings for hybrid circuits in power

microelectronics.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出版公開 号 特開平4-329845

(43)公開日 平成4年(1992)11月18日

(51) Int,CI,* C 2 2 C H 0 1 L	識別記号	庁内蘇理書号 7217-4K	FI	技術表示個所
		7352-4M	H01L 23/14	С

審査請求 有 請求項の数4(全 7 頁)

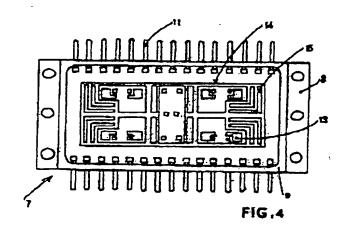
(21)出職番号	特職平3-104862	(71)出版人 591095959
		ベシネ・ルシエルシユ、グループマン・
(22)出藏日	平成3年(1991)4月10日	ンテレ・エコノミツク・レジ・パール・
		ルドナンス・ドユ・23・セプタンプル・
		1967
		フランス国、92400・クールブポワ、ラ・
		デフアンス・5、ブラス・デ・ポージュ
		10、イムーブル・バルザツク
		(72)発明者 サラム・デルマルカール
		フランス国、38430・サン・ジヤン・ド
		ウ・モワラン、ラ・コマンドウリ(番地
		L)
		(74)代理人 弁理士 川口 菴雄 (外2名)
		最終質に統

(54) 【発明の名称】 受動電子部品材料

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】本発明は、高い熱伝導率と、低い密度と、低い 熱影張率とを有する新しい受動電子部品材料を提供する。

【構成】本発明の材料は、純アルミニウム、純マグネシウム、アルミニウム合金及びマグネシウム合金のうちのいずれかである金属と、炭化ケイ素、黒鉛、及びこれらの変形物質のうちのいずれかであるセラミックとから成る、等方性の物理特性を有する複合材料であることを特徴とし、その原金属及びセラミックの構造及び相対比率は特定的に選択される。本発明の材料は、特に電子工学の分野において混成超小型パワー回路の放無部、支持部、放無仮及びパッケージャの製造に適用される。



2

【特許請求の範囲】

【腰球項1】 受動電子部品の製造材料であって、13×10-4/K以下の無膨張率と3100kg/m3以下の需度とを有し、その構造は等方性の物理特性を実現し、アルミニウムとその合金及びマグネシウムとその合金の中から選択された金萬と、緑色炭化ケイ素粒子または多粒子状無鉛であるセラミックとによって構成されており、セラミックは50~90体権%の比率で用いられている受動電子部品材料。

【精水項2】 7×10 「/K~13×10 「/Kの無 膨張率と、150W/m/K以上の熱伝導率と、120 GPa以上のヤング率とを有し、緑色炭化ケイ素粒子が 50~75体積%の比率で用いられていることを特徴と する請求項1に記載の材料。

【請求項3】 4×10 %/K~10×10 %/Kの無 膨張率と、2300kg/m³以下の密度と、100W /m/K以上の無伝導率と、50GPa以下のヤング率 とを有し、多粒子状漏的が65~85件積%の比率で用 いられていることを特徴とする請求項1に記載の材料。

【請求項4】 金属がアルミニウム合金A356または 20 A357であることを特徴とする請求項1に記載の材料。

【兄明の詳細な説明】

[[000]

【産業上の利用分野】本発明は、高い熱伝導率と、低い 密度と、低い熱膨張率とを有する受動電子部品材料に係 わる。

【0002】本明總書中で"受動電子部品"という語は、電子装置の構成要素であって電子的活動に直接関与しないものを意味する。本発明は特に、パワー回路の放 30 熱部、支持部及び磁矩片、レーザダイオードの支持部、混成超小型パワー回路及びマイクロ波回路の放熱板及びパッケージといった構造体の製造材料に保わる。本明細書中に用いた"電子(工学)"という時はオプトエレクトロニクスの分野も包含する。

[0003]

【従来の技術】受動電子部品において上記のような材料 は通常、アルミナなどの絶縁体セラミックやシリコンま たはガリウムヒ素といった半導体から成る基板と結合さ れることが知られている。

【0004】受動電子部品がパワー業子を含む場合、パワー業子動作時に大量の熱が発せられる。この熱は、過剰な加熱による受動電子部品の機係を回避するべく可能なかぎり迅速に発散されなければならない。従って、可能なかぎり高い熱伝導率を有する材料が受動電子部品材料として用いられる。

【0005】とはいえ漢度上昇は不可避であり、受動電子部品材料の熱膨張率が基板材料である絶象体セフミックや半導体の無膨張率とあまりに異なると、基板中に生じる広力が基板材料にとって耐えがたい大きさとなる。

その結果基板材料は破断し、ユニット全体の効率が低下する。

【0006】即ち、受動電子部品材料はアルミナやシリコンの無態張率と適合し得る無能張率を有することも必要であり、この無能張率は好ましくは進度30~400℃で16×10°1/K以下である。

は多粒子状無数であるセラミックとによって構成されて [0007]上記回路はエネルギ源によって駆動される 最助に用いられ得ることから、最物の推進に必要なエネ でいる受動電子部品材料。 ルギ清要を最小限とするべく可能なかぎり低く、好まし 「確求項2] 7×10"/K~13×10"/Kの無 10 くは3100kg/m"以下である密度を有する受動電 が選率と、150W/m/K以上の熱伝導率と、120 子部品材料が求めらる。

> 【0008】また、上記回路はその周囲の環境の影響を受けるので、受動電子部品材料は適当な非磁性と優れた 環境抵抗性とを有するべきである。

> 【0009】これらの特性の部でを折衷して異えた材料を見いだすための研究が盛んに行なわれ、多少とも興味 探い成果が得られた。

[0010] 即ち、銅、ベリリウム、及び或る種のアルミニウム合金といった材料が熱伝導率が優れているというので試されたが、これらの材料は操性率及び熱膨强率が比較的高いので、アルミナの熱膨張率との相違を顕著する目地または接着剤が用いられなければならず、このことはユニット全体の無伝導率を低下させる。

【0011】そこで、コーバル〈鉄・ニッケル・コペルト合金〉や、モリブデンや、第/アンパー/類型の多層金属材料、及びチタンとその合金など、熱態張率の低い材料が研究対象とされた。しかし、これらの材料はモリブデン以外に配て、特に基板の面に対して整値な方向での熱伝導率が低いという欠点を有する。また、いずれの低熱影張率材料も密度が高く、最も低いチタンの密度で約4500kg/m³に達する。更に、モリブデンは高価であり、かつ酸化しやすいので用いにくく、またコーバルは内部広力によって扱れるので機械加工に手廠を要し、コーバルを正確に加工しようとすると多くの境なまして複が必要となる。

[0012]

【短哨が解決しようとする課題】上述のような研究成果から、本出職人は、従来用いられてきた材料には欠疑が存在することに気付いた。そこで本出職人は、有利な器40 特性条析衰して具えた新規な材料、即ち460℃までの進度変化でアルミナのようなセラミック、シリコンまたはガリウムヒ素の熱態張率と適合し得る低い熱態張率を育し、無伝導率は可能なかぎり高く、密度は可能なかぎり低く、環境に対して抵抗性であり、耐食性に優れ、適当に機械加工され得、ニッケル、鑑または金めっきに適し、溶接に適し、非磁性である材料の開発に努めた。

[0013]

【課題を解決するための手段】その結果、等方性の受動 電子部品材料、即ちあらゆる方向において30~250 50 ℃での平均熱膨張率が2×10 1/K~13×101/ 3

Kであり、密度は3100kg/かり以下であり、熱伝等率は100W/m/K以上である受動電子部品材料を開発した。この材料は複合構造を有し、アルミニウムとその合金及びマグネシウムとその合金の中から選択された金属と、緑色炭化ケイ素粒子よたは多粒子状黒鉛であるセラミックとによって構成されており、その原セラミックは50~90体積%の比率で用いられている。

【0014】非常に高い、即ち150W/m/K以上の 熱伝導率と、7×10%/K~13×10%/Kの無態 張率と、120CPa以上のヤング率とを有する材料を 10 得るためには、体積比率50~75%の緑色炭化ケイ素 粒子を用いることが好ましい。

【0015】100W/m/K以上の熱伝導率を維持しつつ4×10- 4 /K~10×10 4 /Kのより低い熱態領率と、2300kg/m 3 以下のより低い密度と、50GPa以下のヤング率とが達成されなければならない場合は、多粒子状黒鉛が65~90体積%の比率で用いられるべきである。

【0016】このように、本発明の材料は、サンドイッチ状に配置された1種以上の金属から成るのではなく、等方性の物理特性を実現する構造を有する金属ーセラミック多相混合物から成る点で従来の材料に異なる。

【0017】 金属は、純アルミニウム、アルミニウム合金、純マグネシウムまたはマグネシウム合金であり得る。これらの金属は実際上、優れた熱伝導率と、低い密度と、低い融点とを併せ持つ。

【0018】合金は、その熱伝導率が添加元素の特性及び量次第で低下し、しかも添加元素が固溶状態で存在すると析出物の形態で存在する場合より甚だしく低下することを考慮して遺捩される。

【0019】アルミニウム合金の場合、添加元素を僅か にしか含有しないものが用いられる。亜鉛、銅、マグネ シウム、鉄及びニッケルは少量なら許容され得るが、マ* *ンガン、デタン、パナジウム及びリチウムの使用は回避 されなければならない。

【0020】好ましくは、Aluminium Association規格の1000、5000及び6000シリーズの合金並びに鋳物合金が用いられる。 鋳物合金であればA356、A357及びA413、2のような、シリコンを7、10及び13%含有する合金が、またAluminium Association規格合金であれば6000シリーズの合金6061及び6101が特に好ましい。

【0021】本発明による材料は、等額粒子の形態、主たは多孔質の多粒子体(polygranular bodies もしくはpolygranular plles)の形態のセラミック成分も含有する。

【0022】 あらゆるセラミックが同様に有効なわけではなく、低い熱膨張率と、高い熱伝導率と、低い密度とを有するセラミックが用いられることが好ましい。

【0023】特に好ましくは、維特性を有利に折衷して 有する炭化ケイ素や多粒子状薫鉛が用いられる。

? 【0024】 炭化ケイ素(SIC) 粒子が用いられる場合、その粒径は0.5~400ミクロン、 好生しくは3~50ミクロンである。

【0025】得られる複合材料が高い熱伝導率を有するべきである場合、SiC粒子は必ず者わめて純粋であって、99質量光以上のSiCを含有しなければならない。この種のSiCを普通"緑色SiC"と呼称する。 "GMELIN Handbook of Inorganic Chemistry," 8thedition, Supplement Vol. B3. p. 60, cd. Springer Verlas, 1986によれば、緑色SiCの組成は次のとお

りである。

[0026]

SiC 遊離C SiO:

SiO₂ Fe₂O₃

A 1:03

99.00~99.4

0.40~ 0.60

 $0.10 \sim 0.20$

0.05~ 0.10

これに比較して、従来の技術で通常用いられている "黒 40% [0027] 色SiC"の組成は次のとおりである。 ※

> SIC 遊廳C

\$ 10:

3 10:

Fe₂O₂

A 1 2 O 2

黒鉛の場合は、個々の粒子の粒径が20ミクロン以下である多孔質多粒子体状のものが用いられる。 黒鉛粒子は 毎触形状を有し、黒鉛多粒子体は、生産される複合材料 50

重量%

0. 05~ 0. 10

0.40 0.00

0. 10 - 0. 20

重量%

98. 75~99. 2

0. 10~ 0. 15

0.50~ 0.70

0.10~ 0.20

0. 25~ 0. 35

の等方性が維持されるようにいかなる特定の方向性も持たない。そのために、特に風鉛繊維が一切排除される。 【0028】セラミックは多孔質プレフォームとして公 5

知である様々な形態で用いられ得、糖に炭化ケイ素の場合は軽集粒子の形態で、また黒鉛の場合は多粒子体の形態で用いられ得る。

【0029】本発明にはセラミックの多孔質プレフォームを、セラミック相の体積分率が50%以上90%以下となるように用いた。実際のところ、上記体積分率が50%以下であると複合材料の熱度場準が高くなりすぎて13×10-1/K以上となり、一カ90%以上であると生産上技術的な問題が出来する。

【0030】プレフォームに被体金属を、加圧及び/または予熱を含み得る当業者に公知の方法で過逝させる (例えばA. G. KELLY and G. I.

DAVIES, Metallurgical Reviews, 1965, Vol. 10, No.

37参照)が、他の任意の公知含提法または鋳造法を用いることも可能である(例えば米国特許第4376804号並びにヨーロッパ特許第0105890号及び同第045510号参照)。

【0031】金属成分が6000シリーズ合金か、合金A356またはA357か、構造的焼入れが起こり得る任業合金である場合、等益等の材料に、その機械特性を改善するべく焼なましまたは焼戻しのような無処理が施される。

【0032】このようにして得られる複合材料は付加的な機械加工及び表面処理(ニッケル、銀または金めっき)を必要とし得、それらの工程は当業者には公知である。

[0033]

【作用】本発明の材料は、該材料と関係付けられる能動及び/または受動電子部品に結合機能(支持部の場合)、結合及び放無機能(放無板の場合)、結合、放無及び接続機能(パッケージの場合)、あるいはまた結合、放無、接続、及び環境の影響からの保護機能(密閉型パッケージの場合)を付与する。

【0034】密閉型パッケージが必要とされる特定の事例では、まずパッケージ本体が形成され、その内部に半導体素子や絶縁体及び能動回路を配置してからこの本体はカパーで養され、カパーはレーザはんだ溶接で固定される。

【0035】最後に、放無板または支持部のような構造 40 体は運宜ワニスまたは樹脂によって保護され持る。

[0036]

【実施例】本発明は、添付図面を参照することによって より良く理解されよう。

【0037】図1に、本発明による材料から成る放無板 1を示す。放無板1上にはアルミナ層によって構成され た絶縁体2が位置し、このアルミナ2上に、入力/出力 技統端了4によって周囲の邸品と接続される能動回路3 が配置されている。

【0038】図2は、図1に示した放熱板1及び絶縁体2を其備した能動回路3の上面図である。能動回路3はサイリスタ5と、導電トラック6と、トラック6の接続端子4とによって構成されている。

【0039】図3には、本発明による材料から成るパッケージ7を示す。パッケージ7の本体はペース8と、ペース8上に位置するフレーム9とによって構成されている。フレーム9は孔10を展え、この孔10を能動回路のための接続端子11が貫通する。フレーム9上部の内順に、カパー12が取り付けられている。

【0040】図4は、ペース8、フレーム9及び接続端子11を有するパッケージ7の内部を示す上面図である。ペース8上に絶縁体13が位置し、絶縁体13上に導電トラック15を含む他動回路14が配置されている。接続端子11と能動回路14との接続は図示しない。

【0041】上述のような集合体の相互接続部分が無サイクル下でも安定した外形寸法と一体性とを維持することが保証されるには、複合材料があらゆる方向において同じ熱態張率を有することが重要である。従って、等方性の複合材料のみを本発明の範囲内とした。

【0042】本発明を、以下の実施例によって詳述する。

【0043】 実施例1

合金AA1050またはA357である金属と、大量の 格子不純物を含有する純度99%以下の黒色SiCか、 主たは僅かな格子不純物しか含有しない純度99%以上 の緑色SICである粒状セラミックとから成る複合材料 を、次の方法で製造する。避集するようにコロイドシリ 力を含有させた、平均粒径44.5ミクロンの5iC粒 千の懸濁袱を算別することによって直径 120mmのブ レフォームを得る。プレフォームを、SIC粒子含量が 5.5体積%、シリカ含量が9.5体積%となるように乾 燥する。乾燥したプレフォームに、ロストワックス鋳造 法で液体金属を浸透させる。固化させ、型抜きして得ら れる複合材料は、理論値に対応する値2975kg/m 3の密度を有する。平均熱壓張率は30~250℃で1。 0. 5×10 1/Kである。この熱彫張率はあらゆる方 向において同じである。ヤング事は125GPa、曲げ 強さは307MPaである。電気抵抗率は11μΩcm である。この複合材料の熱伝導率は、フラッシュ法で熱 拡散率及び単位体積当たりの熱を測定することにより算 出される。得られた実験値(単位はW/m/K)を、S 1 C粒子及び合金の種類と共に次の表1に示す。

表 1

熱伝導率(Y/a/K)

黑色SIC

[0044]

級色SIC

7 会争从1050 合金A357

8 122 170 113 171

複合材料の熱伝導率には合金の選択よりSiC粒子の純度の方がはるかに大きく影響することが知見される。従って、150W/m/K以上の熱伝導率を達成するためには、格子不純物含量が制御され、SiC含量が99質量%以上であるSiC粒子(緑色SiC)を選択しなければならない。

【0045】 変施し、2

合金AA1090と、2600でで黒鉛化されたP.A.N. (ポリアクリロニトリル) 由来の炭素繊維18体積%とを含有し、密度が約2500kg/m³であり、繊維平面に垂直な軸方向での熱伝導率が164W/m/Kであり、繊維平面内で測定される接種方向熱膨張率が30℃で約19×101/K、30~250℃で約6.4×101/K、30~400℃で約3×101/Kである複合材料を製造する。この複合材料の、繊維平面に垂直な軸方向で測定される熱膨張率は30~250℃で55.5×101/Kである。

【0046】この寓庭例は、繊維状のセラミック相を用いることは複合材料の熱影張率を基だしく異方性とするので好ましくないことを示している。

*【0047】この例で、繊維平面に垂直な軸方向での無 即長率は複雑平面内での無形張率のほぼ10倍にも選する。

【0048】 実施例3

多粒子状黑鉛 (Carbone Lorraineの参照番号S2457) と、様々な金属とを含有する複合材 10 料を製造する。用いる金属は、鈍度99、7%以上のアルミニウム(AAI070)、マグネシウム5%含有のアルミニウム合金(AG5)、ニッケル5%含有のアルミニウム合金(AN5)、シリコン7%及びマグネシウム0、6%含有のアルミニウム合金(A357)、並びに亜鉛5%及び希土類金属約1%含有のマグネシウム合金(RZ5)である。

【0049】得られる複合材料を固化させ、型抜きしてから放材料の熱影強率、熱伝導率、密度、場合によっては更に弾性率、解性率及び電気抵抗率の請特性を測定する。得られる特性値は総て等方性である。

【0050】上記測定の結果を表2に示す。 【0051】

表 2

30~250℃での 熱伝導率 密度 ヤング率 曲げ強さ 電気抵抗率

	無應選率					
母材	<u>×10</u> -4/K	W/m/K	kg/m³	<u>GPa</u>	MP a	_ µ Осв
AA1070	6. 0	133	2200	20	58	125
A357	7.4	142	2200	23	128	150
AC5	7. 9	124	2200	-	-	-
ans	5. 3	124	2200	-	-	_
RZ5	6. 5	128	1700	-	-	_

複合材料のアルミニウム及びマグキシウム含量が合金組成に基づき様々となることによって、接特性同士の兼ね合いも様々となる。非常に高い熱伝導率を維持しつつアルミナやガリウムヒ来の熱膨張率にさわめて近似する熱膨張率を達成し得ることが特に留意される。

[0052] 宴施例4

密度の異なる様々な多粒子状黒鉛 (Carbone L orraineの参照番号S2512、S2457及び 40 S2545)と純度99、7%以上のアルミニウムとを 含有する複合材料を製造する。複合材料中の無鉛の比率は50~90体積%とする。

【0053】含浸及び型抜き後に得られる複合材料の無 膨張率、熱伝導率、密度、場合によっては更に挙性率、 断性率及び電気抵抗率を測定する。得られる特性値は起 て等方性である。

【0054】測定結果を表3に示す。

[0055]

衰 3

							# XCHEVE
含量	参照の	熱態强率			雞		\$ 5
	番号						
本積%		×10-4/%	T /m/X	kg/=2	GPa	MPa .	μ Ω ε
82	2512	2. 9	113	2200	18	72	-
69	2457	6.0	133	2200	20	58	125
59	2545	10.0	129	2300	25	32	25
69	2457	6. 0	133	2200	20	58	

開始の種類が異なれば、経特性同士のまね合いも様々 となる。黒鉛S2512を用いると、例えばシリコンや 室化アルミニウムの熱膨强率に毎価の熱膨强率が達成さ れることが特に知見される。

【0056】実施例1~4に説明した本発明による複合 材料とこれらの材料から成る構造体はいずれも、あらゆき *る方向において30~250℃での平均熱膨張率が13 ×10⁻¹/K以下2×10⁻¹/K以上であり、また無伝 導率は100W/m/K以上である。

10

【0057】これらの特性を表4に示す。

[0058]

等方性の物理特性を有する材料

	30~250℃での無寒張率	熱伝導率
<u>複合材料</u>	<u>×10-4/K</u>	#/a/K
释色SiC粒子/AA1050	10.5	170
多粒子状黑鉛S2467/AC6	7. 9	124
多粒子状黑鉛S2457/A367	7.4	142
多粒子状膜的52457/RZ5	6.5	128
多粒子状黑的52457/AA1070	6	133
多粒子状黑鉛52457/AN5	5. 3	124
多粒子状黑鉛\$2512/AA1070	2. 9	113

【図面の簡単な説明】

【関1】パワー回路用の放無板の形態の構造体を含む電 20 7 パッケージ 子部品の側面図である。

【図2】図1の部品の上面図である。

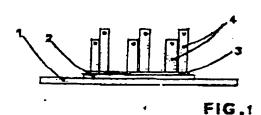
【図3】接続増子及びカバーを具備したパッケージの形 盤の構造体を含む電子部品の側面図である。

【図4】 パッケージからカバーを外したところを示す図 3の部品の上面図である。

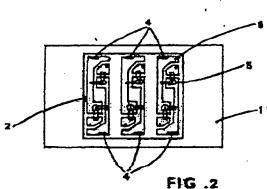
【符号の説明】

- 9 フレーム
- 11 接続端子
- 13 絶縁体
- 14 能動回路
- 15 導電トラック

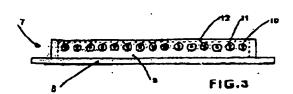
[図1]



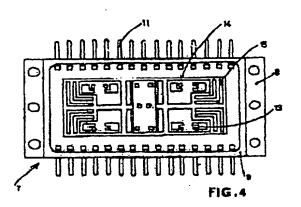
[四2]



[図3]



[四4]



フロントページの焼き

(72) 発明者 グザビエ・デユマン カナダ国、アツシユ・3・エール・S・ウ ー・5・ケペツク、モントリオール、リ ュ・ドウ・シヤンポワ・7330

(72)発明者 ミツシエル・ルバイイ フランス国、84500・ポレーヌ、レ・シヤ ラゴン、シユマン・ジー・エム・カルピエ (香地なし)